



© Tröger Architekten München

### **Komplexe Fertigung Infineon**

Neubau einer komplexen Halbleiterfertigung und Entwicklung eines Standortes mit umfangreichen Erweiterungsmöglichkeiten für die Zukunft

Masterplan, Conceptual Design, Leitdetails, Controlling Planung / Ausführung

## **Komplexe Fertigung Infineon**

Avenida 1 Maio, 801  
Porto, Portugal

**Tröger/Trübsbach Architekten, mra  
Architekten**

Bauherrschaft

**Infineon Semi-Conductors**

Auftraggeber

**Siemens Immobilien Management SIM  
PA**

Planungsbeginn

**1996**

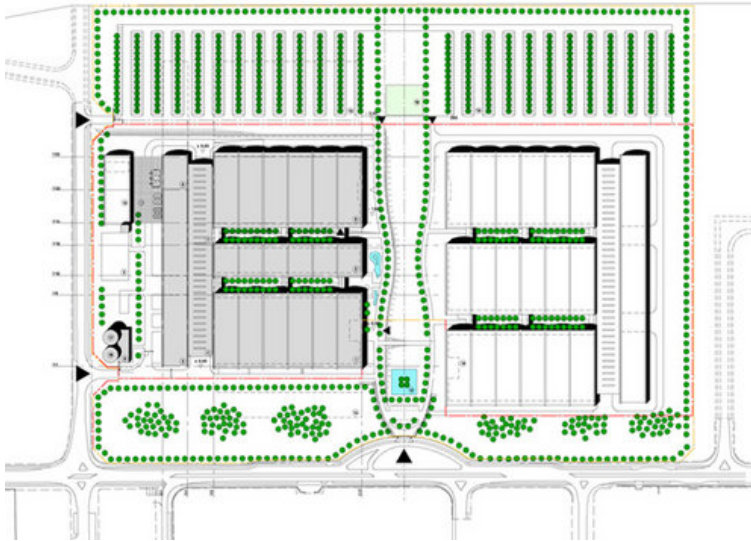
Bauende

**2001**

Bruttogeschossfläche

**29.000 m<sup>2</sup>**





© Tröger Architekten München

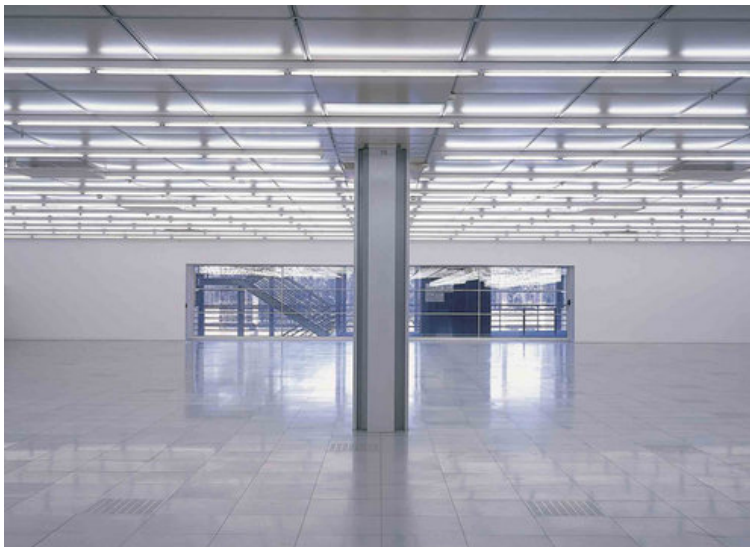
### Komplexe Fertigung Infineon

Infineon Semi-Conductors\_Komplexe  
Fertigung Halbleiter  
Porto/Portugal\_Lageplan



© Tröger Architekten München

Infineon Semi-Conductors\_Komplexe  
Fertigung Halbleiter  
Porto/Portugal\_Außenbereich



© Tröger Architekten München

Infineon Semi-Conductors\_Komplexe  
Fertigung Halbleiter  
Porto/Portugal\_Licht und Material

### Komplexe Fertigung Infineon



© Tröger Architekten München

Infineon Semi-Conductors\_Komplexe  
Fertigung Halbleiter  
Porto/Portugal\_Einblicke



© Tröger Architekten München

Infineon Semi-Conductors\_Komplexe  
Fertigung Halbleiter  
Porto/Portugal\_Außenwirkung